	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS001D(单胞)	文件编号	XS-R-045
		版本号	18-B2-05
	肖特基二极管	页 码	1/3

1 主要用途及主要特点

1.1 主要用途

用 W1XS001D 封装的成品管主要用于通讯设备保护线圈。

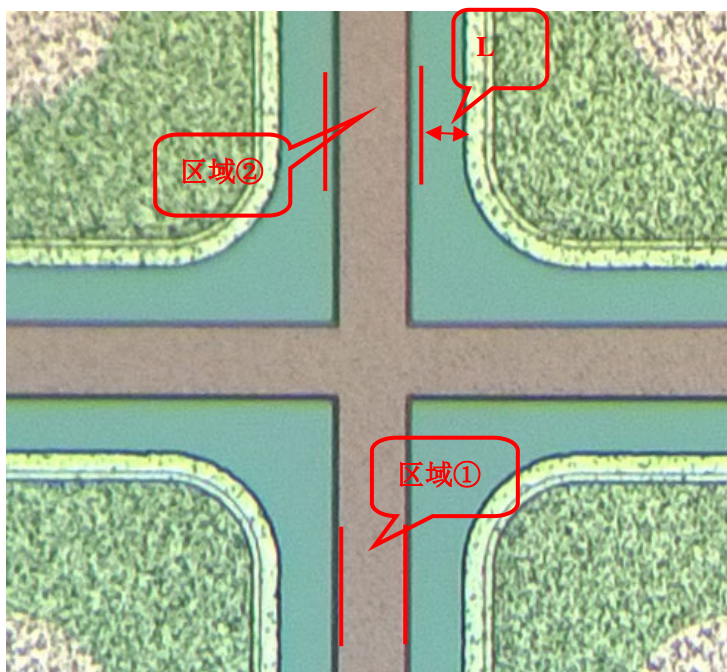
1.2 主要特点

- 低正向压降
- 高电导性
- 高可靠性

2 芯片数据

芯片示意图	芯片尺寸		0.63 mm×0.63 mm	
			24.80 mil×24.80	
	芯片厚度 (μm) (推荐)		≤180um	
	划片道*尺寸 (μm)		50	
	键合区面积 (μm ²)	正面	300×300	
	正面电极 (阳极)	金属	铝	
		厚度	5.0±1.0	
	背面电极 (阴极)	表层金属	金	银
	装片要求 (推荐)		共晶	低温共晶
	硅片直径 (mm)		φ 125	
键合要求 (推荐)		1 根 φ 32 μm 铜线		

* 划片道位置示意图:



备注: 区域①为划片刀走刀区域, 划片时应在两条参考线中间; 区域②为划片道区域, 宽度为 50 μm; 划片时划片道边缘到铝的距离 L 不小于 20 μm 即判定为合格。


江阴新顺微电子有限公司

地 址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电 话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS001D(单胞) 肖特基二极管	文件编号	XS-R-045
		版本号	18-B2-05
		页码	2/3

3 电特性(在推荐的封装形式、适当的封装条件下)

3.1 极限值

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

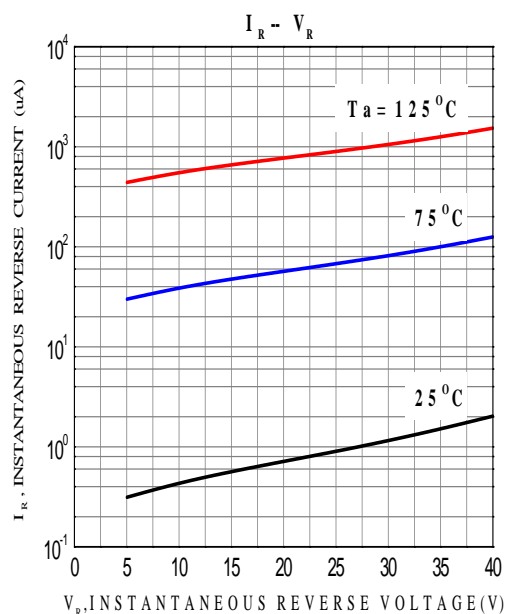
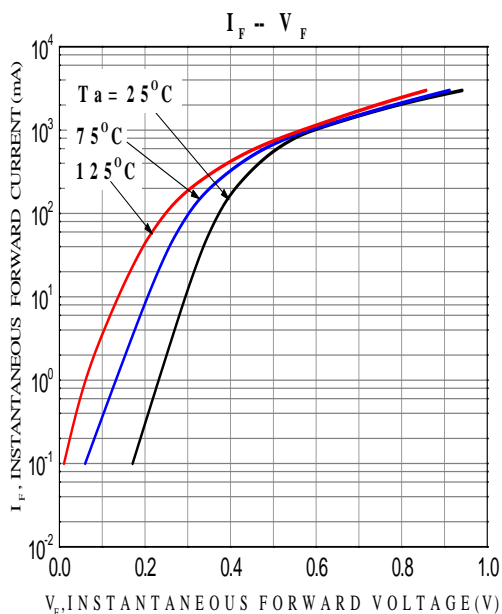
参数名称	符号	额定值	单位	备注
峰值反向电压	V_{RM}	40	V	推荐封装形式: SOD-123 推荐成品型号: B0540W
正向电流	I_D	0.5	A	
结温	T_j	150	$^{\circ}\text{C}$	
贮存温度	T_{stg}	-40~150	$^{\circ}\text{C}$	

3.2 电参数

除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	测试条件	规范值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V_{BR}	$I_R=20\mu\text{A}$	40	—	—	V
反向电流	I_{R1}	$V_{R1}=20\text{V}$	—	0.8	10	μA
反向电流	I_{R2}	$V_{R2}=40\text{V}$	—	2.5	20	μA
正向电压	V_{F1}	$I_{F1}=500\text{mA}$	—	0.49	0.51	V
正向电压	V_{F2}	$I_{F2}=1\text{A}$	—	0.59	0.62	V
总电容	C_{tot}	$V_R=0\text{V}, f=1\text{MHz}$	—	90	170	pF

3.3 典型特性曲线




江阴新顺微电子有限公司

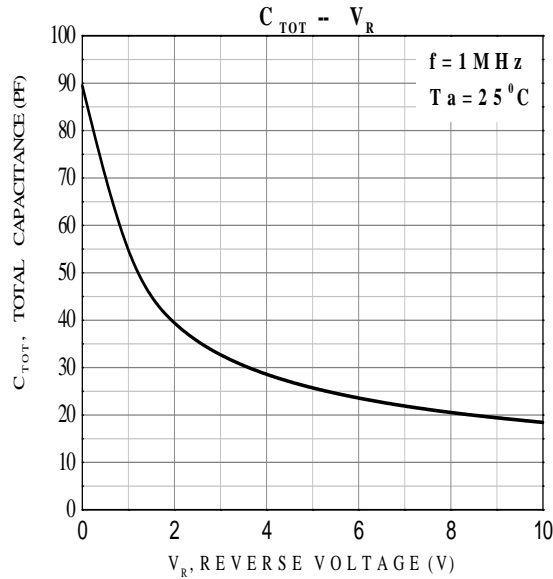
地址: 江苏省江阴市长山大道 78 号

网址: [Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)

电话: (0510) 86851182

传真: (0510) 86851532

	江阴新顺微电子有限公司分立器件芯片 W1XS001D(单胞)	文件编号	XS-R-045
	肖特基二极管	版本号	18-B2-05
		页码	3/3



注意事项:

- 芯片存储条件（推荐）：氮气保护，温度 $25 \pm 5^\circ\text{C}$ ，湿度 $\leq 45\%$ ；
- 本产品说明书仅供参考，不作为合同的一部分，具体以双方签订的技术协议为准；
- 本产品说明书如有版本变更，恕不另行告知！客户在下单前应获取最新版本资料并验证相关信息是否完整和更新；
- 任何半导体产品在特定条件下都有发生失效或故障的可能，买方有责任在使用新顺产品时遵守安全使用标准并采取安全措施，以避免潜在的失效或故障风险造成人身伤害或财产损失的发生。

江阴新顺微电子有限公司

地 址：江苏省江阴市长山大道 78 号
电 话：（0510）86851182

网 址：[Http://www.xs-elec.com](http://www.xs-elec.com)
传 真：（0510）86851532